

Family list**6 family members for: JP10301146**

Derived from 5 applications

1 SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE**Inventor:** YAMAZAKI SHUNPEI; ONUMA HIDETO; **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
(+2)**EC:** **IPC:** G02F1/136; G02F1/1368; H01L21/336
(+13)**Publication info:** JP10301146 A - 1998-11-13**2 SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE****Inventor:** YAMAZAKI SHUNPEI; ONUMA HIDETO; **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
(+2)**EC:** **IPC:** G02F1/136; G02F1/1368; H01L21/336
(+13)**Publication info:** JP10301147 A - 1998-11-13**3 Semiconductor device and method of fabricating the same****Inventor:** YAMAZAKI SHUNPEI (JP); OHNUMA HIDETO (JP); (+2) **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP)**EC:** H01L21/77T; G02B27/01C; (+2) **IPC:** H01L21/336; H01L21/84; H01L27/12 (+6)**Publication info:** US6133075 A - 2000-10-17**4 Semiconductor device and method of fabricating the same****Inventor:** YAMAZAKI SHUNPEI (JP); OHNUMA HIDETO (JP); (+2) **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP)**EC:** H01L21/77T; G02B27/01C; (+2) **IPC:** H01L21/336; H01L21/84; H01L27/12 (+6)**Publication info:** US6524896 B1 - 2003-02-25**5 Semiconductor device and method of fabricating the same****Inventor:** YAMAZAKI SHUNPEI (JP); OHNUMA HIDETO (JP); (+2) **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP)**EC:** H01L21/77T; G02B27/01C; (+2) **IPC:** H01L21/336; H01L21/84; H01L27/12 (+6)**Publication info:** US6864127 B2 - 2005-03-08**US2003138996 A1** - 2003-07-24

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

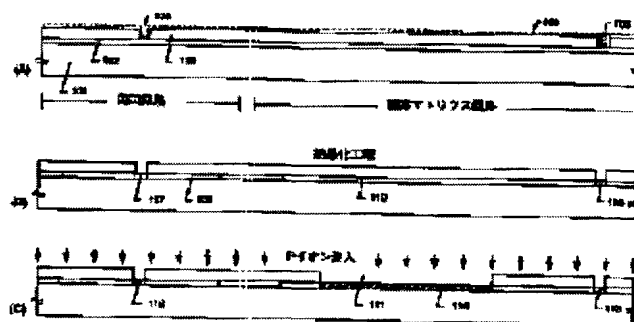
SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

Patent number: JP10301146
Publication date: 1998-11-13
Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI; ONUMA HIDETO; TAKANO TAMAE; OTANI HISASHI
Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
Classification:
- international: *G02F1/136; G02F1/1368; H01L21/336; H01L21/822; H01L27/04; H01L29/786; G02F1/13; H01L21/02; H01L21/70; H01L27/04; H01L29/66; (IPC1-7): G02F1/136; H01L21/336; H01L21/822; H01L27/04; H01L29/786*
- european:
Application number: JP19970123283 19970425
Priority number(s): JP19970123283 19970425

Report a data error here

Abstract of JP10301146

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify a production process and to improve throughput and yield by commonly constituting a process for forming regions for gettering catalyst elements and a process for forming the lower electrodes of auxiliary capacitors. **SOLUTION:** The mask insulating film 103 on an amorphous silicon film 102 is provided with first apertures 104, 105 and a nickel-contg. layer 106 is formed by applying a soln. contg. nickel as the catalyst element for assisting the crystallization of silicon thereon (A). The nickel is diffused into the amorphous silicon film 102 by a heat treatment and is crystallized, by which crystal silicon films 107 to 110 are formed (B). The second apertures 111 are then formed at the mask insulating film 103 and phosphorus ions are added as a group 15 element to getter the catalyst element (C). Consequently, the phosphorus added regions 112, 113 under the apertures 104, 105 function as the gettering regions of the nickel and the phosphorus added regions 114 under the apertures 11 function as the gettering regions simultaneously when the regions turn to the lower electrodes of the auxiliary capacitors.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-301146

(43) 公開日 平成10年(1998)11月13日

(51) Int. Cl.⁶
G02F 1/136
H01L 27/04
21/822
29/786
21/336

識別記号
500

F I
G02F 1/136 500
H01L 27/04 C
29/78 612 Z
627 G

審査請求 未請求 請求項の数20 F D (全17頁)

(21) 出願番号 特願平9-123283
(22) 出願日 平成9年(1997)4月25日

(71) 出願人 000153878
株式会社半導体エネルギー研究所
神奈川県厚木市長谷398番地
(72) 発明者 山崎 舜平
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内
(72) 発明者 大沼 英人
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内
(72) 発明者 高野 圭恵
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

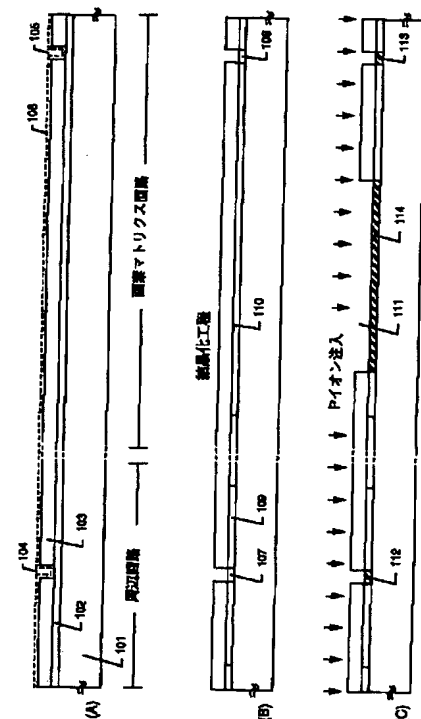
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその作製方法

(57) 【要約】

【課題】 半導体装置の作製工程の簡略化を実現するための技術を提供する。

【解決手段】 珪素を含む非晶質膜102上に開口部104、105を有した絶縁膜103を形成する。次に開口部から触媒元素を導入して結晶化を行う。結晶化後、絶縁膜103に開口部111を形成し、Pイオンを添加する。この工程により触媒元素をゲッタリングさせるための領域112、113と後に補助容量の下部電極として機能する領域114とを同時に形成することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】画素マトリクス回路を構成する複数の画素領域のそれぞれに少なくとも一つの半導体素子及び補助容量を有する半導体装置であって、

前記補助容量を構成する一対の電極の少なくとも一方は、15族から選ばれた元素により導電性を与えられた珪素を含む半導体膜で構成され、
前記珪素を含む半導体膜には珪素の結晶化を助長する触媒元素が存在することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】画素マトリクス回路を構成する複数の画素領域のそれぞれに少なくとも一つの半導体素子及び補助容量を有する半導体装置であって、
前記半導体素子の活性層及び前記補助容量を構成する一対の電極の少なくとも一方は、珪素を含む半導体膜で構成され、
前記補助容量を構成する一対の電極の一方は、15族から選ばれた元素と珪素の結晶化を助長する触媒元素とを含み、
前記触媒元素の濃度は前記活性層の少なくともチャンネル形成領域に含まれる触媒元素の濃度よりも高いことを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】珪素を含む半導体膜で形成された半導体素子で構成される周辺回路及び画素マトリクス回路を有する半導体装置において、
前記画素マトリクス回路を構成する複数の画素領域のそれぞれは少なくとも一つの補助容量を有し、
前記補助容量を構成する一対の電極の少なくとも一方は、15族から選ばれた元素を含む前記半導体膜で構成され、
前記補助容量を構成する一対の電極の一方は、珪素の結晶化を助長する触媒元素を含み、
前記触媒元素の濃度は前記半導体素子の少なくともチャンネル形成領域に含まれる触媒元素の濃度よりも高いことを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】請求項 1 乃至 2 において、珪素を含む半導体膜は特定の方向に規則性をもって並んだ針状または柱状結晶が複数集合してなる結晶構造を有していることを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】請求項 1 乃至 3 において、補助容量を構成する一対の電極の一方には、前記触媒元素が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ atoms/cm² の濃度で含まれることを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】請求項 1 乃至 3 または 5 において、触媒元素とは Ni、Co、Fe、Pd、Pt、Cu、Au から選ばれた少なくとも一つの元素であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 7】請求項 1 乃至 3 において、15族から選ばれた元素とは P、As、Sb、Bi から選ばれた少なくとも一つの元素であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 8】珪素を含む非晶質膜の全部または一部に対

して該珪素の結晶化を助長する触媒元素を保持または添加する工程と、

加熱処理により前記珪素を含む非晶質膜の素子形成部を結晶化させる工程と、

前記素子形成部に隣接する領域および補助容量の下部電極となる領域に対して15族から選ばれた元素を同時に添加する工程と、

加熱処理により前記15族から選ばれた元素を添加した領域に前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 9】珪素を含む非晶質膜上に第1の開口部を有する絶縁膜を形成する工程と、

前記絶縁膜をマスクとして前記珪素を含む非晶質膜に対して該珪素の結晶化を助長する触媒元素を保持または添加する工程と、

加熱処理により前記非晶質膜の素子形成部を結晶化させる工程と、

前記絶縁膜に第2の開口部を形成する工程と、

前記結晶化工程で得られた珪素を含む膜のうち、第1及び第2の開口部の底部に露出した領域に対して15族から選ばれた元素を同時に添加する工程と、

加熱処理により前記15族から選ばれた元素を添加した領域に前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 10】請求項 9 において、第2の開口部は補助容量の下部電極となる領域上に形成されることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 11】同一基板上に周辺回路と画素マトリクス回路とを有する半導体装置の作製方法において、

珪素を含む非晶質膜上の前記画素マトリクス回路となる領域のみに絶縁膜を形成する工程と、

前記絶縁膜に開口部を形成する工程と、

前記絶縁膜をマスクとして前記珪素を含む非晶質膜に対して該珪素の結晶化を助長する触媒元素を保持または添加する工程と、

加熱処理により前記珪素を含む非晶質膜の素子形成部を結晶化させる工程と、

前記素子形成部に隣接する領域および補助容量の下部電極となる領域に15族から選ばれた元素を同時に添加する工程と、

加熱処理により前記15族から選ばれた元素を添加した領域に前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 12】同一基板上に周辺回路と画素マトリクス回路とを有する半導体装置の作製方法において、

珪素を含む非晶質膜上の前記周辺回路となる領域のみに絶縁膜を形成する工程と、

前記絶縁膜に開口部を形成する工程と、

前記絶縁膜をマスクとして前記珪素を含む非晶質膜に対して該珪素の結晶化を助長する触媒元素を保持または添

加する工程と、

加熱処理により前記珪素を含む非晶質膜の素子形成部を結晶化させる工程と、

前記素子形成部に隣接する領域および補助容量の下部電極となる領域に 1 5 族から選ばれた元素を同時に添加する工程と、

加熱処理により前記 1 5 族から選ばれた元素を添加した領域に前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 3】同一基板上に周辺回路と画素マトリクス回路とを有する半導体装置の作製方法において、

珪素を含む非晶質膜のうち、前記周辺回路となる領域の全部または一部のみに対して該珪素の結晶化を助長する触媒元素を保持または添加する工程と、

加熱処理により前記周辺回路となる領域の素子形成部を結晶化させる工程と、

前記素子形成部に隣接する領域および補助容量の下部電極となる領域に 1 5 族から選ばれた元素を同時に添加する工程と、

加熱処理により前記 1 5 族から選ばれた元素を添加した領域に前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 4】請求項 8、9、1 1、1 2 または 1 3 において、前記 1 5 族から選ばれた元素を添加する工程はゲッタリング領域を形成する工程と補助容量の下部電極を形成する工程とを兼ねることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 5】請求項 8、9、1 1、1 2 または 1 3 において、触媒元素として N i、C o、F e、P d、P t、C u、A u から選ばれた少なくとも一つの元素が用いられることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 6】請求項 8、9、1 1、1 2 または 1 3 において、触媒元素はイオンプラントレーション法により添加されることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 7】請求項 8、9、1 1、1 2 または 1 3 において、1 5 族から選ばれた元素として P、A s S b、B i から選ばれた少なくとも一つの元素が用いられることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 8】請求項 8、9、1 1、1 2 または 1 3 において、1 5 族から選ばれた元素を添加する工程は、イオンプラントレーション法またはプラズマドーピング法で行われることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 9】請求項 8、9、1 1、1 2 または 1 3 において、1 5 族から選ばれた元素を添加する工程は $1 \times 10^{13} \sim 8 \times 10^{15}$ atoms/cm² のドーズ量で行われることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2 0】請求項 8、9、1 1、1 2 または 1 3 において、1 5 族から選ばれた元素によるゲッタリング工程は 5 0 0 ~ 7 0 0 °C で行われることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明が属する技術分野】本発明は半導体薄膜を利用した半導体装置およびその作製方法に関する技術であり、特に珪素を含む結晶性膜を利用した薄膜トランジスタ

(Thin Film Transistor: T F T) に関する。

【0 0 0 2】なお、本明細書において、半導体装置とは半導体を利用して機能する装置全般を指すものであり、T F T、M O S F E T (I G F E T) の如き半導体素子のみならず、電気光学装置 (液晶表示装置等) やそれを搭載した応用製品 (電子デバイス等) も半導体装置の範疇に含まれるものとする。本明細書中では区別を明確にするため、適宜半導体素子、表示装置等と記載する。

【0 0 0 3】

【従来の技術】近年、基板上に形成した薄膜トランジスタ (T F T) で半導体回路を形成する技術の進歩が著しい。特に、薄膜半導体として結晶性珪素膜 (ポリシリコン膜等) を用い、同一基板上に周辺回路と画素マトリクス回路とを搭載したアクティブマトリクス型表示装置が実用化レベルに達している。

【0 0 0 4】中でもアクティブマトリクス型液晶表示装置 (以下、A M - L C D と呼ぶ) はノートパソコン、プロジェクター、携帯機器等のディスプレイ用として活発に開発が進められている。A M - L C D はその動作モードによって透過型 L C D と反射型 L C D とに大別される。

【0 0 0 5】また現在、高精細かつ明るい液晶表示装置の開発が急がれ、X G A (1024×768 画素) や S X G A (1280×1024 画素) の様に各画素が 30 μm 角以下の極めて微細なものとなる構造が開発されている。

【0 0 0 6】上述の様な A M - L C D は液晶層に印加した電圧によって液晶層の光学応答特性を変化させ、光のオン/オフ制御を行う。また、通常は液晶層に保持した電荷の漏れを補うため、補助容量を各画素に設ける構成となる。

【0 0 0 7】ところで、本発明者らは珪素を含む結晶性膜の形成方法として、結晶化を助長する触媒元素 (代表的にはニッケル) を利用して結晶性膜を得る方法を開示している (特開平 7-130652 号公報参照)。

【0 0 0 8】同公報では触媒元素を直接添加して結晶化させた領域 (以下、縦成長領域と呼ぶ) と、触媒元素を添加した領域の周囲に形成される結晶化領域 (以下、横成長領域と呼ぶ) とを形成する技術が開示されている。

【0 0 0 9】しかしながら、触媒元素は殆どが金属元素であるため、結晶化後に残存すると T F T の信頼性を損ねる恐れがあり好ましくない。

【0 0 1 0】

【発明が解決しようとする課題】本願発明は、上記触媒元素を効果的に除去または低減する工程を有する半導体装置の作製方法において、製造工程を簡略化するための

技術を提供することを課題とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】本明細書で開示する発明の構成は、珪素を含む非晶質膜の全部または一部に対して該珪素の結晶化を助長する触媒元素を保持または添加する工程と、加熱処理により前記珪素を含む非晶質膜の素子形成部を結晶化させる工程と、前記素子形成部に隣接する領域および補助容量の下部電極となる領域に対して15族から選ばれた元素を同時に添加する工程と、加熱処理により前記15族から選ばれた元素を添加した領域に前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、を有することを特徴とする。

【0012】本発明の基本的な目的は、珪素を含む非晶質膜の結晶化に使用した触媒元素を形成後の結晶性膜からゲッタリングする作製方法において、その工程を簡略化することにある。

【0013】ここで上記触媒元素のゲッタリング方法について簡単に説明する。本発明の構成の一つに、15族から選ばれた元素によるゲッタリング効果を利用する特徴がある。

【0014】上記触媒元素としてはNi（ニッケル）、Co（コバルト）、Fe（鉄）、Pd（パラジウム）、Pt（白金）、Cu（銅）、Au（金）が代表的である。本発明者らの実験では、ニッケルが最も適した元素であることが判明している。

【0015】また、上記触媒元素をゲッタリングする15族元素としては、N（窒素）、P（リン）、As（砒素）、Sb（アンチモン）、Bi（ビスマス）が挙げられるが、特に顕著な作用効果を示すのはリンである。

【0016】典型的な例としては、触媒元素としてニッケル、ゲッタリング元素（15族元素）としてリンを使用した場合、600℃前後の加熱処理によってリンとニッケルが安定な結合状態を示す。この時、Ni₃P、Ni₂P₂、Ni₃P₂、Ni₂P₃、Ni₃P₄、Ni₄P₃、Ni₅P₃、Ni₆P₃、Ni₇P₃、Ni₈P₃、Ni₉P₃、Ni₁₀P₃、Ni₁₁P₃、Ni₁₂P₃、Ni₁₃P₃、Ni₁₄P₃、Ni₁₅P₃、Ni₁₆P₃、Ni₁₇P₃、Ni₁₈P₃、Ni₁₉P₃、Ni₂₀P₃、Ni₂₁P₃、Ni₂₂P₃、Ni₂₃P₃、Ni₂₄P₃、Ni₂₅P₃、Ni₂₆P₃、Ni₂₇P₃、Ni₂₈P₃、Ni₂₉P₃、Ni₃₀P₃、Ni₃₁P₃、Ni₃₂P₃、Ni₃₃P₃、Ni₃₄P₃、Ni₃₅P₃、Ni₃₆P₃、Ni₃₇P₃、Ni₃₈P₃、Ni₃₉P₃、Ni₄₀P₃、Ni₄₁P₃、Ni₄₂P₃、Ni₄₃P₃、Ni₄₄P₃、Ni₄₅P₃、Ni₄₆P₃、Ni₄₇P₃、Ni₄₈P₃、Ni₄₉P₃、Ni₅₀P₃、Ni₅₁P₃、Ni₅₂P₃、Ni₅₃P₃、Ni₅₄P₃、Ni₅₅P₃、Ni₅₆P₃、Ni₅₇P₃、Ni₅₈P₃、Ni₅₉P₃、Ni₆₀P₃、Ni₆₁P₃、Ni₆₂P₃、Ni₆₃P₃、Ni₆₄P₃、Ni₆₅P₃、Ni₆₆P₃、Ni₆₇P₃、Ni₆₈P₃、Ni₆₉P₃、Ni₇₀P₃、Ni₇₁P₃、Ni₇₂P₃、Ni₇₃P₃、Ni₇₄P₃、Ni₇₅P₃、Ni₇₆P₃、Ni₇₇P₃、Ni₇₈P₃、Ni₇₉P₃、Ni₈₀P₃、Ni₈₁P₃、Ni₈₂P₃、Ni₈₃P₃、Ni₈₄P₃、Ni₈₅P₃、Ni₈₆P₃、Ni₈₇P₃、Ni₈₈P₃、Ni₈₉P₃、Ni₉₀P₃、Ni₉₁P₃、Ni₉₂P₃、Ni₉₃P₃、Ni₉₄P₃、Ni₉₅P₃、Ni₉₆P₃、Ni₉₇P₃、Ni₉₈P₃、Ni₉₉P₃、Ni₁₀₀P₃、Ni₁₀₁P₃、Ni₁₀₂P₃、Ni₁₀₃P₃、Ni₁₀₄P₃、Ni₁₀₅P₃、Ni₁₀₆P₃、Ni₁₀₇P₃、Ni₁₀₈P₃、Ni₁₀₉P₃、Ni₁₁₀P₃、Ni₁₁₁P₃、Ni₁₁₂P₃、Ni₁₁₃P₃、Ni₁₁₄P₃、Ni₁₁₅P₃、Ni₁₁₆P₃、Ni₁₁₇P₃、Ni₁₁₈P₃、Ni₁₁₉P₃、Ni₁₂₀P₃、Ni₁₂₁P₃、Ni₁₂₂P₃、Ni₁₂₃P₃、Ni₁₂₄P₃、Ni₁₂₅P₃、Ni₁₂₆P₃、Ni₁₂₇P₃、Ni₁₂₈P₃、Ni₁₂₉P₃、Ni₁₃₀P₃、Ni₁₃₁P₃、Ni₁₃₂P₃、Ni₁₃₃P₃、Ni₁₃₄P₃、Ni₁₃₅P₃、Ni₁₃₆P₃、Ni₁₃₇P₃、Ni₁₃₈P₃、Ni₁₃₉P₃、Ni₁₄₀P₃、Ni₁₄₁P₃、Ni₁₄₂P₃、Ni₁₄₃P₃、Ni₁₄₄P₃、Ni₁₄₅P₃、Ni₁₄₆P₃、Ni₁₄₇P₃、Ni₁₄₈P₃、Ni₁₄₉P₃、Ni₁₅₀P₃、Ni₁₅₁P₃、Ni₁₅₂P₃、Ni₁₅₃P₃、Ni₁₅₄P₃、Ni₁₅₅P₃、Ni₁₅₆P₃、Ni₁₅₇P₃、Ni₁₅₈P₃、Ni₁₅₉P₃、Ni₁₆₀P₃、Ni₁₆₁P₃、Ni₁₆₂P₃、Ni₁₆₃P₃、Ni₁₆₄P₃、Ni₁₆₅P₃、Ni₁₆₆P₃、Ni₁₆₇P₃、Ni₁₆₈P₃、Ni₁₆₉P₃、Ni₁₇₀P₃、Ni₁₇₁P₃、Ni₁₇₂P₃、Ni₁₇₃P₃、Ni₁₇₄P₃、Ni₁₇₅P₃、Ni₁₇₆P₃、Ni₁₇₇P₃、Ni₁₇₈P₃、Ni₁₇₉P₃、Ni₁₈₀P₃、Ni₁₈₁P₃、Ni₁₈₂P₃、Ni₁₈₃P₃、Ni₁₈₄P₃、Ni₁₈₅P₃、Ni₁₈₆P₃、Ni₁₈₇P₃、Ni₁₈₈P₃、Ni₁₈₉P₃、Ni₁₉₀P₃、Ni₁₉₁P₃、Ni₁₉₂P₃、Ni₁₉₃P₃、Ni₁₉₄P₃、Ni₁₉₅P₃、Ni₁₉₆P₃、Ni₁₉₇P₃、Ni₁₉₈P₃、Ni₁₉₉P₃、Ni₂₀₀P₃、Ni₂₀₁P₃、Ni₂₀₂P₃、Ni₂₀₃P₃、Ni₂₀₄P₃、Ni₂₀₅P₃、Ni₂₀₆P₃、Ni₂₀₇P₃、Ni₂₀₈P₃、Ni₂₀₉P₃、Ni₂₁₀P₃、Ni₂₁₁P₃、Ni₂₁₂P₃、Ni₂₁₃P₃、Ni₂₁₄P₃、Ni₂₁₅P₃、Ni₂₁₆P₃、Ni₂₁₇P₃、Ni₂₁₈P₃、Ni₂₁₉P₃、Ni₂₂₀P₃、Ni₂₂₁P₃、Ni₂₂₂P₃、Ni₂₂₃P₃、Ni₂₂₄P₃、Ni₂₂₅P₃、Ni₂₂₆P₃、Ni₂₂₇P₃、Ni₂₂₈P₃、Ni₂₂₉P₃、Ni₂₃₀P₃、Ni₂₃₁P₃、Ni₂₃₂P₃、Ni₂₃₃P₃、Ni₂₃₄P₃、Ni₂₃₅P₃、Ni₂₃₆P₃、Ni₂₃₇P₃、Ni₂₃₈P₃、Ni₂₃₉P₃、Ni₂₄₀P₃、Ni₂₄₁P₃、Ni₂₄₂P₃、Ni₂₄₃P₃、Ni₂₄₄P₃、Ni₂₄₅P₃、Ni₂₄₆P₃、Ni₂₄₇P₃、Ni₂₄₈P₃、Ni₂₄₉P₃、Ni₂₅₀P₃、Ni₂₅₁P₃、Ni₂₅₂P₃、Ni₂₅₃P₃、Ni₂₅₄P₃、Ni₂₅₅P₃、Ni₂₅₆P₃、Ni₂₅₇P₃、Ni₂₅₈P₃、Ni₂₅₉P₃、Ni₂₆₀P₃、Ni₂₆₁P₃、Ni₂₆₂P₃、Ni₂₆₃P₃、Ni₂₆₄P₃、Ni₂₆₅P₃、Ni₂₆₆P₃、Ni₂₆₇P₃、Ni₂₆₈P₃、Ni₂₆₉P₃、Ni₂₇₀P₃、Ni₂₇₁P₃、Ni₂₇₂P₃、Ni₂₇₃P₃、Ni₂₇₄P₃、Ni₂₇₅P₃、Ni₂₇₆P₃、Ni₂₇₇P₃、Ni₂₇₈P₃、Ni₂₇₉P₃、Ni₂₈₀P₃、Ni₂₈₁P₃、Ni₂₈₂P₃、Ni₂₈₃P₃、Ni₂₈₄P₃、Ni₂₈₅P₃、Ni₂₈₆P₃、Ni₂₈₇P₃、Ni₂₈₈P₃、Ni₂₈₉P₃、Ni₂₉₀P₃、Ni₂₉₁P₃、Ni₂₉₂P₃、Ni₂₉₃P₃、Ni₂₉₄P₃、Ni₂₉₅P₃、Ni₂₉₆P₃、Ni₂₉₇P₃、Ni₂₉₈P₃、Ni₂₉₉P₃、Ni₃₀₀P₃、Ni₃₀₁P₃、Ni₃₀₂P₃、Ni₃₀₃P₃、Ni₃₀₄P₃、Ni₃₀₅P₃、Ni₃₀₆P₃、Ni₃₀₇P₃、Ni₃₀₈P₃、Ni₃₀₉P₃、Ni₃₁₀P₃、Ni₃₁₁P₃、Ni₃₁₂P₃、Ni₃₁₃P₃、Ni₃₁₄P₃、Ni₃₁₅P₃、Ni₃₁₆P₃、Ni₃₁₇P₃、Ni₃₁₈P₃、Ni₃₁₉P₃、Ni₃₂₀P₃、Ni₃₂₁P₃、Ni₃₂₂P₃、Ni₃₂₃P₃、Ni₃₂₄P₃、Ni₃₂₅P₃、Ni₃₂₆P₃、Ni₃₂₇P₃、Ni₃₂₈P₃、Ni₃₂₉P₃、Ni₃₃₀P₃、Ni₃₃₁P₃、Ni₃₃₂P₃、Ni₃₃₃P₃、Ni₃₃₄P₃、Ni₃₃₅P₃、Ni₃₃₆P₃、Ni₃₃₇P₃、Ni₃₃₈P₃、Ni₃₃₉P₃、Ni₃₄₀P₃、Ni₃₄₁P₃、Ni₃₄₂P₃、Ni₃₄₃P₃、Ni₃₄₄P₃、Ni₃₄₅P₃、Ni₃₄₆P₃、Ni₃₄₇P₃、Ni₃₄₈P₃、Ni₃₄₉P₃、Ni₃₅₀P₃、Ni₃₅₁P₃、Ni₃₅₂P₃、Ni₃₅₃P₃、Ni₃₅₄P₃、Ni₃₅₅P₃、Ni₃₅₆P₃、Ni₃₅₇P₃、Ni₃₅₈P₃、Ni₃₅₉P₃、Ni₃₆₀P₃、Ni₃₆₁P₃、Ni₃₆₂P₃、Ni₃₆₃P₃、Ni₃₆₄P₃、Ni₃₆₅P₃、Ni₃₆₆P₃、Ni₃₆₇P₃、Ni₃₆₈P₃、Ni₃₆₉P₃、Ni₃₇₀P₃、Ni₃₇₁P₃、Ni₃₇₂P₃、Ni₃₇₃P₃、Ni₃₇₄P₃、Ni₃₇₅P₃、Ni₃₇₆P₃、Ni₃₇₇P₃、Ni₃₇₈P₃、Ni₃₇₉P₃、Ni₃₈₀P₃、Ni₃₈₁P₃、Ni₃₈₂P₃、Ni₃₈₃P₃、Ni₃₈₄P₃、Ni₃₈₅P₃、Ni₃₈₆P₃、Ni₃₈₇P₃、Ni₃₈₈P₃、Ni₃₈₉P₃、Ni₃₉₀P₃、Ni₃₉₁P₃、Ni₃₉₂P₃、Ni₃₉₃P₃、Ni₃₉₄P₃、Ni₃₉₅P₃、Ni₃₉₆P₃、Ni₃₉₇P₃、Ni₃₉₈P₃、Ni₃₉₉P₃、Ni₄₀₀P₃、Ni₄₀₁P₃、Ni₄₀₂P₃、Ni₄₀₃P₃、Ni₄₀₄P₃、Ni₄₀₅P₃、Ni₄₀₆P₃、Ni₄₀₇P₃、Ni₄₀₈P₃、Ni₄₀₉P₃、Ni₄₁₀P₃、Ni₄₁₁P₃、Ni₄₁₂P₃、Ni₄₁₃P₃、Ni₄₁₄P₃、Ni₄₁₅P₃、Ni₄₁₆P₃、Ni₄₁₇P₃、Ni₄₁₈P₃、Ni₄₁₉P₃、Ni₄₂₀P₃、Ni₄₂₁P₃、Ni₄₂₂P₃、Ni₄₂₃P₃、Ni₄₂₄P₃、Ni₄₂₅P₃、Ni₄₂₆P₃、Ni₄₂₇P₃、Ni₄₂₈P₃、Ni₄₂₉P₃、Ni₄₃₀P₃、Ni₄₃₁P₃、Ni₄₃₂P₃、Ni₄₃₃P₃、Ni₄₃₄P₃、Ni₄₃₅P₃、Ni₄₃₆P₃、Ni₄₃₇P₃、Ni₄₃₈P₃、Ni₄₃₉P₃、Ni₄₄₀P₃、Ni₄₄₁P₃、Ni₄₄₂P₃、Ni₄₄₃P₃、Ni₄₄₄P₃、Ni₄₄₅P₃、Ni₄₄₆P₃、Ni₄₄₇P₃、Ni₄₄₈P₃、Ni₄₄₉P₃、Ni₄₅₀P₃、Ni₄₅₁P₃、Ni₄₅₂P₃、Ni₄₅₃P₃、Ni₄₅₄P₃、Ni₄₅₅P₃、Ni₄₅₆P₃、Ni₄₅₇P₃、Ni₄₅₈P₃、Ni₄₅₉P₃、Ni₄₆₀P₃、Ni₄₆₁P₃、Ni₄₆₂P₃、Ni₄₆₃P₃、Ni₄₆₄P₃、Ni₄₆₅P₃、Ni₄₆₆P₃、Ni₄₆₇P₃、Ni₄₆₈P₃、Ni₄₆₉P₃、Ni₄₇₀P₃、Ni₄₇₁P₃、Ni₄₇₂P₃、Ni₄₇₃P₃、Ni₄₇₄P₃、Ni₄₇₅P₃、Ni₄₇₆P₃、Ni₄₇₇P₃、Ni₄₇₈P₃、Ni₄₇₉P₃、Ni₄₈₀P₃、Ni₄₈₁P₃、Ni₄₈₂P₃、Ni₄₈₃P₃、Ni₄₈₄P₃、Ni₄₈₅P₃、Ni₄₈₆P₃、Ni₄₈₇P₃、Ni₄₈₈P₃、Ni₄₈₉P₃、Ni₄₉₀P₃、Ni₄₉₁P₃、Ni₄₉₂P₃、Ni₄₉₃P₃、Ni₄₉₄P₃、Ni₄₉₅P₃、Ni₄₉₆P₃、Ni₄₉₇P₃、Ni₄₉₈P₃、Ni₄₉₉P₃、Ni₅₀₀P₃、Ni₅₀₁P₃、Ni₅₀₂P₃、Ni₅₀₃P₃、Ni₅₀₄P₃、Ni₅₀₅P₃、Ni₅₀₆P₃、Ni₅₀₇P₃、Ni₅₀₈P₃、Ni₅₀₉P₃、Ni₅₁₀P₃、Ni₅₁₁P₃、Ni₅₁₂P₃、Ni₅₁₃P₃、Ni₅₁₄P₃、Ni₅₁₅P₃、Ni₅₁₆P₃、Ni₅₁₇P₃、Ni₅₁₈P₃、Ni₅₁₉P₃、Ni₅₂₀P₃、Ni₅₂₁P₃、Ni₅₂₂P₃、Ni₅₂₃P₃、Ni₅₂₄P₃、Ni₅₂₅P₃、Ni₅₂₆P₃、Ni₅₂₇P₃、Ni₅₂₈P₃、Ni₅₂₉P₃、Ni₅₃₀P₃、Ni₅₃₁P₃、Ni₅₃₂P₃、Ni₅₃₃P₃、Ni₅₃₄P₃、Ni₅₃₅P₃、Ni₅₃₆P₃、Ni₅₃₇P₃、Ni₅₃₈P₃、Ni₅₃₉P₃、Ni₅₄₀P₃、Ni₅₄₁P₃、Ni₅₄₂P₃、Ni₅₄₃P₃、Ni₅₄₄P₃、Ni₅₄₅P₃、Ni₅₄₆P₃、Ni₅₄₇P₃、Ni₅₄₈P₃、Ni₅₄₉P₃、Ni₅₅₀P₃、Ni₅₅₁P₃、Ni₅₅₂P₃、Ni₅₅₃P₃、Ni₅₅₄P₃、Ni₅₅₅P₃、Ni₅₅₆P₃、Ni₅₅₇P₃、Ni₅₅₈P₃、Ni₅₅₉P₃、Ni₅₆₀P₃、Ni₅₆₁P₃、Ni₅₆₂P₃、Ni₅₆₃P₃、Ni₅₆₄P₃、Ni₅₆₅P₃、Ni₅₆₆P₃、Ni₅₆₇P₃、Ni₅₆₈P₃、Ni₅₆₉P₃、Ni₅₇₀P₃、Ni₅₇₁P₃、Ni₅₇₂P₃、Ni₅₇₃P₃、Ni₅₇₄P₃、Ni₅₇₅P₃、Ni₅₇₆P₃、Ni₅₇₇P₃、Ni₅₇₈P₃、Ni₅₇₉P₃、Ni₅₈₀P₃、Ni₅₈₁P₃、Ni₅₈₂P₃、Ni₅₈₃P₃、Ni₅₈₄P₃、Ni₅₈₅P₃、Ni₅₈₆P₃、Ni₅₈₇P₃、Ni₅₈₈P₃、Ni₅₈₉P₃、Ni₅₉₀P₃、Ni₅₉₁P₃、Ni₅₉₂P₃、Ni₅₉₃P₃、Ni₅₉₄P₃、Ni₅₉₅P₃、Ni₅₉₆P₃、Ni₅₉₇P₃、Ni₅₉₈P₃、Ni₅₉₉P₃、Ni₆₀₀P₃、Ni₆₀₁P₃、Ni₆₀₂P₃、Ni₆₀₃P₃、Ni₆₀₄P₃、Ni₆₀₅P₃、Ni₆₀₆P₃、Ni₆₀₇P₃、Ni₆₀₈P₃、Ni₆₀₉P₃、Ni₆₁₀P₃、Ni₆₁₁P₃、Ni₆₁₂P₃、Ni₆₁₃P₃、Ni₆₁₄P₃、Ni₆₁₅P₃、Ni₆₁₆P₃、Ni₆₁₇P₃、Ni₆₁₈P₃、Ni₆₁₉P₃、Ni₆₂₀P₃、Ni₆₂₁P₃、Ni₆₂₂P₃、Ni₆₂₃P₃、Ni₆₂₄P₃、Ni₆₂₅P₃、Ni₆₂₆P₃、Ni₆₂₇P₃、Ni₆₂₈P₃、Ni₆₂₉P₃、Ni₆₃₀P₃、Ni₆₃₁P₃、Ni₆₃₂P₃、Ni₆₃₃P₃、Ni₆₃₄P₃、Ni₆₃₅P₃、Ni₆₃₆P₃、Ni₆₃₇P₃、Ni₆₃₈P₃、Ni₆₃₉P₃、Ni₆₄₀P₃、Ni₆₄₁P₃、Ni₆₄₂P₃、Ni₆₄₃P₃、Ni₆₄₄P₃、Ni₆₄₅P₃、

る。また、109、110は横方向に結晶化が進行した横成長領域であり、 $5 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{19}$ atoms/cm² 程度のニッケルを含む。また、結晶化に至らなかった領域は非晶質のまま残存する。

【0031】この横成長領域は特定の方向に規則性をもって並んだ針状または柱状結晶が集合した結晶構造となっている。また、各針状結晶は互いに概略平行に、巨視的には同一の方向に向かって成長しているという特徴がある。

【0032】次に、上記マスク絶縁膜103を再びパターニングして後に補助容量となる電極部（下部電極部）を形成するための第2の開口部111を形成する。なお、マスク絶縁膜103を完全に除去した後に、開口部を有するレジストマスクを新たに設ける構成とすることも可能である。

【0033】そして、その状態でイオンプランテーション法またはプラズマドーピング法によりP（リン）イオンを添加する。Pイオンの代わりにAs（砒素）イオンを用いても有効である。（図1（C））

【0034】本実施例のイオン注入工程は加速電圧を5～25kVとし、ドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 8 \times 10^{15}$ atoms/cm²（好ましくは $5 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15}$ atoms/cm²）とする。この様な設定とすることで、露出した非晶質珪素膜中には $5 \times 10^{13} \sim 2 \times 10^{15}$ atoms/cm²の濃度でPイオンが添加される。

【0035】本実施例の特徴は、まずニッケル添加領域として機能した第1の開口部104、105がリンを添加する領域としても機能する点である。第1の開口部104、105の下に形成されたリン添加領域112、113はニッケルを集めるゲッタリング領域として機能する。

【0036】また、第2の開口部111の下に形成されたリン添加領域114は、N型導電性を有する補助容量の下部電極となる。そして、同時にニッケルを集めるゲッタリング領域としても機能する。

【0037】この様に、ゲッタリング領域を形成する目的でPイオンを添加する工程が、補助容量の下部電極を形成する工程を兼ねている点が本願発明の最も重要な構成の一つである。

【0038】Pイオンの添加工程が終了したら、マスク絶縁膜103を除去した後、窒素雰囲気中で400～700℃（代表的には550～600℃）、2～24時間（代表的には8～12時間）の加熱処理を行い、横成長領域109、110に存在するニッケルをリン添加領域112～114の方へと移動させる。（図2（A））

【0039】なお、この工程はマスク絶縁膜103を除去する前に行っても構わない。また、加熱処理の前にレーザーアニール等の処理を行い、珪素膜中のリンを分散させておくことも有効である。このレーザーアニールを行う場合、マスク絶縁膜103を除去した後にレーザー

アニールを施した方が効果的である。なお、レーザー光としてはKrF、ArF、XeCl等を励起ガスとするエキシマレーザー、CO₂レーザーおよびYAGレーザー等を利用することができる。

【0040】こうして横成長領域109、110に残留していたニッケルはリン添加領域112～114にゲッタリングされ、ニッケルが低減された横成長領域115、116が得られる。なお、リン元素によるゲッタリング工程については本発明者らが特願平9-94607号で開示している。（図2（A））

【0041】また、リン添加領域112～114はPイオンを添加する工程で非晶質化するが、この加熱処理工程で再び結晶化する。

【0042】なお、本発明者らがSIMS（質量二次イオン分析）で確認した結果、図2（A）に示す工程の後に横成長領域115、116に含まれるニッケル濃度は、少なくとも 5×10^{17} atoms/cm²以下（これ以下は検出下限となって測定不能）にまで低減されていることが判明した。

【0043】そして、この時、リン添加領域112～114はニッケルがゲッタリングされて集まるため高濃度にニッケルを含有する領域となる。SIMSによる分析では $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{20}$ atoms/cm²の濃度でニッケルの存在が確認されている。

【0044】ただし、後に補助容量の下部電極として機能するリン添加領域114はニッケルが残存していたとしても電極として機能すれば問題はない。また、リン添加領域112、113は少なくともチャネル形成領域には使用しない（ソース／ドレイン領域としては使用できる）。従って、基本的には活性層を形成する時点で除去するのでニッケルの有無は問題ではない。

【0045】こうして図2（A）の状態が得られたら、珪素膜をパターニングして活性層117～119を形成する。なお、活性層117、118はそれぞれ主に周辺回路を構成するCMOS回路のN型TFT、P型TFTとなる。また、活性層119は画素マトリクス回路を構成する画素TFT（本実施例ではN型TFTとする）となる。

【0046】次に、珪素膜表面に形成された酸化物（図示せず）を除去する。この様な表面酸化物は珪素膜中の汚染物等を取り込んでいるため、除去することで清浄な珪素膜表面を得ることができる。

【0047】そして、ただちにゲイト絶縁膜となる酸化珪素膜120をプラズマCVD法を用いて10～150nmの厚さに形成する。勿論、減圧熱CVD法、スパッタ法を用いることもできる。ECRプラズマCVD法や高密度プラズマCVD法でも効果的である。（図2（B））

【0048】次に、アルミニウムまたはアルミニウムを主成分とする材料でなる電極パターン121～124を形成する。電極パターン121～124はそれぞれCM

OS回路または画素TFTを構成するゲート電極の原型である。また、電極パターン124は補助容量の上部電極の原型である。

【0049】なお、本実施例では画素TFTとしてトリプルゲート型TFTを採用するため、電極パターン123を三つに分けて記載するが実際には全て繋がった同一電極である。

【0050】こうして図3(A)の状態が得られたら、次に2回の陽極酸化工程を行う。なお、以下に記載する陽極酸化工程からイオン注入(リン(P)またはボロン(B))に至るまでの工程は、本発明者らによる特開平7-135318号公報記載の技術によるものである。従って、詳細な条件等は同公報を参考にするが良い。

【0051】電極パターン121~124を形成した後、まず、3%シュウ酸水溶液中で陽極酸化を行い、多孔質状の陽極酸化膜125~128を形成する。次に、3%酒石酸を混合したエチレングリコール溶液中で陽極酸化を行い、無孔質状の陽極酸化膜129~132を形成する。また、これら2回の陽極酸化工程の後、ゲート電極133~135、補助容量の上部電極136が画定

【0052】こうして図3(B)に示す状態が得られたら、ゲート電極および多孔質状の陽極酸化膜をマスクとしてゲート絶縁膜120のドライエッチングを行う。この工程より137~140で示される様なゲート絶縁膜が形成される。なお、ゲート絶縁膜140は補助容量のキャパシタ絶縁膜として機能する。(図3(C))

【0053】次に、図3(D)に示す様に多孔質状の陽極酸化膜125~128を除去し、高加速Pイオン注入及び低加速Pイオン注入を行う。この工程によってN型TFTのソース領域141、ドレイン領域142、一対の低濃度不純物領域(LDD領域とも呼ばれる)143、チャンネル形成領域144が形成される。

【0054】また、本実施例では画素TFTをN型TFTで構成するため、画素TFTのソース領域145、ドレイン領域146、一対の低濃度不純物領域147~149、チャンネル形成領域150~152が形成される。

【0055】なお、この時P型TFTの活性層にもPイオンが添加されて前述のソース/ドレイン領域と同濃度のPイオンを含んだ領域153、154及び前述の低濃度不純物領域と同濃度のPイオンを含んだ領域155が形成される。また、156で示される領域にはPイオンは全く添加されず、予め添加したPイオン濃度が保たれるが、実質的に画素TFTとドレイン領域146と一体化してしまう。

【0056】次に、P型TFTのみが露出する様にレジストマスク157を設け、高加速Bイオン注入及び低加速Bイオン注入を行う。この工程によって図3(D)におけるPイオンを含んだ領域153~155は全てP型に反転してP型TFTのソース領域158、ドレイン領

域159、一対の低濃度不純物領域160、チャンネル形成領域161が形成される。(図4(A))

【0057】以上の様なイオン注入工程を利用すると、1回のパターニング工程のみでN型TFTとP型TFTのソース/ドレイン領域を形成することができる。

【0058】次に、レジストマスク157を除去した状態でファーネスアニール、レーザーアニール、ランプアニールのいずれかの手段またはそれらを併用した手段によって注入したPイオンおよびBイオンの活性化を行う。また、これと同時にイオン注入により崩れた活性層の結晶性を修復する。

【0059】次に、第1の層間絶縁膜162として酸化珪素膜及び窒化珪素膜でなる積層膜を形成する。そして、コンタクトホールを形成した後、ソース電極163~165及びドレイン電極166、167を形成する。(図4(B))

【0060】次に、第2の層間絶縁膜168として有機性樹脂膜(ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、アクリル等)を0.5~3 μ m(好ましくは1.5~2.5 μ m)の厚さに形成する。有機性樹脂膜の最も大きな特徴は比誘電率が低い(2.0~3.4程度)ことであり、これにより配線間の寄生容量を大幅に低減することができる。即ち、ロジック回路など高周波駆動を必要とする回路を構成する際に動作速度の低下を効果的に抑制することができる。

【0061】次に、第2の層間絶縁膜168にコンタクトホールを形成して、画素電極169を形成する。なお、本実施例では画素電極169をアルミニウムまたはアルミニウムを主成分とする材料で構成する。

【0062】最後に、得られたTFT全体を水素雰囲気において加熱処理して水素化を行い、活性層中のダングリングボンドの低減を図る。こうして、図4(C)に示す様な、CMOS回路および画素TFTが同一基板上に一体形成されたアクティブマトリクス基板が完成する。

【0063】この後は、公知のセル組み工程によって上記アクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶層を挟持すれば反射型液晶表示装置が完成する。

【0064】液晶材料の種類、セルギャップ等の設計事項は実施者が適宜決定すれば良い。また、本実施例ではブラックマスクを対向側に設ける構成としているが、アクティブマトリクス基板側の必要箇所に設ける構成としても良い。

【0065】〔実施例2〕本実施例では実施例1とは異なる手段で結晶性珪素膜を形成する例について説明する。なお、基本的に異なる工程は実施例1の図1

(A)、(B)、(C)に対応する工程(リン元素によるゲッタリング工程の手前の工程)だけなので、これらの工程についてのみ説明することとする。

【0066】本実施例では、非晶質珪素膜を結晶化する手段として特開平7-130625号公報記載の技術の縦成長領

域の形成方法を利用する。

【0067】図5(A)において、501は基板、502は非晶質珪素膜である。縦成長領域を形成する場合、実施例1の様なマスク絶縁膜は必要なく、非晶質珪素膜502の全面に対してニッケル含有層503を形成すれば良い。

【0068】この時、ニッケルを含有した溶液内のニッケル濃度は重量換算で10ppm（非晶質珪素膜の表面で約 3×10^{13} atoms/cm²）で良い。

【0069】この状態で結晶化のための加熱処理を行う。本実施例では600℃4時間とする。この加熱処理により非晶質珪素膜502は全面が結晶化し、縦成長領域と呼ばれる結晶性珪素膜504が得られる。（図5(B)）

【0070】次に、レジストマスク505を形成する。レジストマスク505にはPイオンを添加するための開口部506～508が形成される。そして、開口部506～508を形成したら、Pイオンの注入工程を行い、リン添加領域509～511を形成する。（図5(C)）

【0071】この時、開口部506、507からPイオンが添加された領域509、510はニッケルを集めるゲッタリング領域として機能する。このゲッタリング領域の形成箇所は、素子形成部から離れすぎるとゲッタリング効果が小さくなるので素子形成部に隣接する領域が好ましい。

【0072】また、開口部508からPイオンが添加された領域511は補助容量の下部電極として機能する。勿論、下部電極としての機能に加えてゲッタリング領域としての機能も兼ねている。

【0073】以上の様な工程で図5(C)に示す状態が得られる。この後は実施例1と同様の工程に従って半導体装置を作製すれば良い。

【0074】〔実施例3〕本実施例では同一基板上で縦成長領域と横成長領域とを使い分けて半導体装置を作製する例について説明する。なお、基本的にはリン元素によるゲッタリング工程までが異なるのみで、実施例1や実施例2と類似の工程であるので必要な部分のみを説明することにする。

【0075】図6(A)において、601は基板、602は非晶質珪素膜である。本実施例では周辺回路を横成長領域で形成し、画素マトリクス回路を縦成長領域で形成する構成とする。そのため、マスク絶縁膜603は画素マトリクス回路となる領域には形成しない様にし、周辺回路となる領域では必要箇所に開口部604を設ける。

【0076】そして、ニッケルを含有した溶液を塗布し、スピンコートすることによりニッケル含有層605を形成する。この時、溶液内のニッケル濃度は実施例1と同様に重量換算で100ppmとすれば良い。これ以下の濃

度では横成長領域の成長距離が所望の長さにまで達しない恐れがある。（図6(A)）

【0077】この状態で結晶化のための加熱処理を行う。本実施例では横成長を十分に行わすために600℃8時間とする。この加熱処理により周辺回路となる領域ではニッケル添加領域（縦成長領域とも言える）606、横成長領域607が形成される。また、画素マトリクス回路となる領域では非晶質珪素膜602の全面が結晶化し、縦成長領域608が形成される。（図6(B)）

【0078】そして、マスク絶縁膜603を除去した後、開口部610～612を設けたレジストマスク609を形成し、Pイオンの注入工程を行ってリン添加領域613～615を形成する。（図6(C)）

【0079】本実施例でも実施例1、実施例2と同様に、リン添加領域613、614はニッケルを集めるゲッタリング領域として機能し、リン添加領域615は補助容量の下部電極として機能する。勿論、下部電極としての機能に加えてゲッタリング領域としての機能も兼ねている。

20 【0080】以上の様な工程で図6(C)に示す状態が得られる。この後は実施例1と同様の工程に従って半導体装置を作製すれば良い。

【0081】〔実施例4〕本実施例では実施例3とは異なる構成で縦成長領域と横成長領域とを使い分ける例について説明する。なお、本実施例もリン元素によるゲッタリング工程までを説明するにとどめる。

30 【0082】図7(A)において、701は基板、702は非晶質珪素膜である。本実施例では周辺回路を縦成長領域で形成し、画素マトリクス回路を横成長領域で形成する構成とする。そのため、マスク絶縁膜703は周辺回路となる領域には形成しない様にし、画素マトリクス回路となる領域では必要箇所に開口部704を設ける。

【0083】そして、ニッケルを含有した溶液を塗布し、スピンコートすることによりニッケル含有層705を形成する。この時、溶液内のニッケル濃度は実施例3と同様に重量換算で100ppmとすれば良い。（図7(A)）

40 【0084】この状態で結晶化のための加熱処理を行う。本実施例では横成長を十分に行わすために600℃8時間とする。この加熱処理により画素マトリクス回路となる領域ではニッケル添加による縦成長領域706、横成長領域707が形成される。また、周辺回路となる領域では非晶質珪素膜702の全面が結晶化し、縦成長領域708が形成される。（図7(B)）

【0085】そして、マスク絶縁膜703を除去した後、開口部710～712を設けたレジストマスク709を形成し、Pイオンの注入工程を行ってリン添加領域713～715を形成する。（図7(C)）

50 【0086】本実施例でも実施例1乃至実施例3と同様

に、リン添加領域 7 1 3、7 1 4 はニッケルを集めるゲッターリング領域として機能し、リン添加領域 7 1 5 は補助容量の下部電極として機能する。勿論、下部電極としての機能に加えてゲッターリング領域としての機能も兼ねている。

【0087】以上の様な工程で図 7 (C) に示す状態が得られる。この後は実施例 1 と同様の工程に従って半導体装置を作製すれば良い。

【0088】〔実施例 5〕本実施例では、補助容量の下部電極を構成する領域をニッケル添加領域として活用する場合の例について説明する。なお、本実施例もリン元素によるゲッターリング工程までを説明するにとどめる。

【0089】図 8 (A) において、8 0 1 は基板、8 0 2 は非晶質珪素膜である。その上にマスク絶縁膜 8 0 3 を形成し、マスク絶縁膜 8 0 3 には開口部 8 0 4、8 0 5 を形成する。この時、開口部 8 0 5 は後に補助容量の下部電極となる領域に形成する点に本実施例の特徴がある。

【0090】そして、ニッケルを含有した溶液を塗布し、スピコートすることによりニッケル含有層 8 0 6 を形成する。この時、溶液内のニッケル濃度は実施例 3 および実施例 4 と同様に重量換算で 100ppm とすれば良い。(図 8 (A))

【0091】この状態で結晶化のための加熱処理を行う。本実施例ではこの加熱処理を 570℃ 14 時間とする。この様に結晶化温度を 560℃ まで下げることによって自然核発生による結晶化を十分に防ぐことができる。自然核発生が生じるとそこで横方向への結晶成長が止まってしまうことが起こりうるので好ましくない。

【0092】この加熱処理により周辺回路となる領域ではニッケル添加による縦成長領域 8 0 7、横成長領域 8 0 8 が形成される。また、画素マトリクス回路となる領域ではニッケル添加による縦成長領域 8 0 9、横成長領域 8 1 0 が形成される。(図 8 (B))

【0093】そして、図 8 (C) に示す様にマスク絶縁膜 8 0 3 をそのままマスクとして P イオンの注入工程を行い、リン添加領域 8 1 1、8 1 2 を形成する。この後は実施例 1 と同様の工程に従って半導体装置を作製すれば良い。

【0094】本実施例の場合、ニッケルの添加工程に用いたマスク絶縁膜 8 0 3 をそのままリン添加工程のマスクとして用いることができるため、製造工程が簡略化されるという利点がある。

【0095】〔実施例 6〕本実施例では画素マトリクス回路に全くニッケルを添加しない構成とする例について説明する。なお、この構成では周辺回路を縦成長領域で構成しても横成長領域で構成しても良いが、本実施例では周辺回路を横成長領域で形成する例について説明する。

【0096】図 9 (A) において、9 0 1 は基板、9 0

2 は非晶質珪素膜、9 0 3 はマスク絶縁膜である。本実施例の場合、周辺回路となる領域においてマスク絶縁膜 6 0 3 に開口部 9 0 4 を形成する。画素マトリクス回路となる領域には開口部は形成しない。

【0097】そして、ニッケルを含有した溶液を塗布し、スピコートすることによりニッケル含有層 9 0 5 を形成する。この時、溶液内のニッケル濃度は重量換算で 100ppm とすれば良い。(図 9 (A))

【0098】この状態で結晶化のための加熱処理を行う。本実施例では 560℃ 20 時間で結晶化工程を行う。この加熱処理により周辺回路となる領域ではニッケル添加による縦成長領域 9 0 6、横成長領域 9 0 7 が形成される。また、画素マトリクス回路となる領域ではニッケルが全く添加されないので非晶質領域 9 0 8 が残存する。

(図 9 (B))

【0099】そして、マスク絶縁膜 9 0 3 を除去した後、開口部 9 1 0、9 1 1 を設けたレジストマスク 9 0 9 を形成し、P イオンの注入工程を行ってリン添加領域 9 1 2、9 1 3 を形成する。なお、この時点でリン添加領域 9 1 2、9 1 3 は一旦非晶質化する。(図 9 (C))

【0100】次に、600℃ 24 時間程度の加熱処理を行い、リン元素によるゲッターリング工程を行う。この工程により横成長領域 9 1 4 に含まれるニッケルは、リン添加領域 9 1 5 へとゲッターリングされる。(図 10 (A))

【0101】また、ゲッターリング領域となったリン添加領域 9 1 5 はこの加熱処理により再結晶化する。さらに、後に補助容量の下部電極として機能するリン添加領域 9 1 6 もこの加熱処理により再結晶化する。

【0102】そして、前述の非晶質領域 9 0 8 も自然核発生による結晶化が進行し、結晶領域 9 1 7 となる。この場合、後に補助容量の下部電極となるリン添加領域 9 1 6 はゲッターリング領域として機能しないのでニッケルは殆ど含まれない。

【0103】そして、図 10 (A) の状態が得られたら、必要箇所をパターニングにより残して活性層 9 1 8 ~ 9 2 0 を形成する。そして、実施例 1 の工程に従ってゲイト絶縁膜 9 2 1 を形成する。

【0104】以上の様な工程で図 10 (B) に示す状態が得られる。この後は実施例 1 と同様の工程に従って半導体装置を作製すれば良い。

【0105】〔実施例 7〕本実施例では図 2 (A) に示したリン元素によるゲッターリング工程の加熱方法としてランプアニールを用いる例を示す。

【0106】ランプアニールによる加熱処理としては R T A (ラピッド・サーマル・アニール) が知られている。これはハロゲンランプ等を用いた赤外光を試料に対して照射し、薄膜を加熱する技術である。

【0107】ゲッターリング工程における加熱処理として

10

20

30

40

50

R T A を利用すると、700~1100℃という高温アニール処理を数秒から数分と短い時間で処理することができ、従って、ファーンズアニールよりも高温処理ができるので触媒元素のゲッターリング効果が向上する。また、処理時間もはるかに短いのでスループットも大幅に向上する。

【0108】さらに、700~1100℃という高い温度による加熱処理によって結晶性珪素膜の結晶粒界付近に存在する珪素原子の再配列がなされ、結晶粒界の不活性化が促進する。即ち、不對結合手の如き結晶欠陥が大幅に減少してキャリアが捕獲される可能性が低くなり、全体的な結晶性が著しく改善される。

【0109】〔実施例8〕本発明では、触媒元素（代表的にはニッケル）の添加方法としてイオンプラントーション法を用いることもできる。この場合、ドーズ量は $0.5 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^2$ （好ましくは $2 \times 10^{13} \sim 2 \times 10^{14} \text{ atoms/cm}^2$ ）となる様に調節することが好ましい。

【0110】本実施例の様にイオンプラントーション法で触媒元素を添加する場合、マスク絶縁膜に設ける開口部の幅（短辺）は $0.01 \sim 5 \mu\text{m}$ （代表的には $0.25 \sim 2 \mu\text{m}$ ）程度で良い。即ち、微細なパターンに形成された開口部に対しても十分な量のニッケルを添加することが可能である。

【0111】従って、回路設計の段階においてデッドスペースとなる触媒元素の添加領域の占有面積を大幅に低減することができるため、回路設計の自由度が向上するという利点が得られる。

【0112】〔実施例9〕実施例1ではゲイト電極としてアルミニウムまたはアルミニウムを主成分とする材料を用いたが、本発明はゲイト電極として一導電性を有する結晶性珪素膜を用いることも可能である。

【0113】また、チタン、タンタル、タングステン、モリブデン等の金属材料やそれら金属材料と珪素との化合物でなる金属シリサイド等をゲイト電極として用いることもできる。

【0114】〔実施例10〕実施例1乃至実施例9では代表的なTFT構造の一例としてプレーナ型TFTの例を示しているが、他にも逆スタガ型TFTなどのボトムゲイト型TFTを本発明に適用することも可能である。

【0115】また、TFTに限らず、シリコンウェハ上に形成されたMOSFETに対して適用することも可能である。

【0116】この様に、本願発明は半導体素子（半導体装置）の構造によらず適用することが可能であり、特定構造の半導体素子に限定されるものではない。

【0117】〔実施例11〕本実施例では画素マトリクス回路を構成する画素構成の一例を図11に示す。ただし、構造を簡略化するため画素電極は省略してある。

【0118】図11において11は活性層であり、図2

(C)の活性層119に対応する。本実施例では活性層11のドレイン側を、画素内いっばいに広がる様に形成しており、補助容量の下部電極12を兼ねる点に特徴がある。

【0119】その上方にはゲイト絶縁膜を介してゲイト線13が配置されている。ゲイト線13は図3(B)のゲイト電極135に対応する。また、ゲイト線13とは別に補助容量の上部電極14が形成される。この上部電極14は図3(B)の上部電極136に対応する。

【0120】この場合、上部電極14は下部電極となる活性層とほぼ一致する様な形状に設けられており、ほぼ画素の占有面積の相当する補助容量を形成する。また、隣接する画素間で上部電極14は電氣的に接続されている（ゲイト線とクロスしない様にゲイト線と平行に接続する）。即ち、全ての画素において補助容量の上部電極は同電位に保たれる。

【0121】次に、ゲイト線13及び補助容量の上部電極14の上には第1の層間絶縁膜を介してソース電極（ソース線）15及びドレイン電極16が形成される。これらの電極はそれぞれは図4(B)のソース電極165とドレイン電極167に対応する。

【0122】そして、図示していないが、後は図4(C)に示す様に層間絶縁膜168と画素電極169を形成して、公知のセル組み工程を行えば反射型液晶表示装置が完成する。本実施例の様な構造とすると、画素面積が小さくなくてもその面積を最大限に生かして補助容量を確保することが可能である。

【0123】〔実施例12〕本発明は透過型液晶表示装置に適用することもできる。なお、TFTの作製工程は基本的に実施例1で説明した通りなので、詳細な説明は省略する。

【0124】実施例1では画素電極としてアルミニウムを主成分とする材料を用いているが、本実施例では透明導電膜としてITO膜を用いる。また、透過型では開口率を大きくとることが重要な課題となるので、電界遮蔽膜やブラックマスク等は必要な箇所に最小限の大きさで設ければ良い。

【0125】ここで、本実施例の透過型液晶表示装置を上面から見た図を図12に示す。なお、特定の構造を分かり易く説明するためにソース／ドレイン電極を形成した状態の上面図を説明する。従って、画素電極、電界遮蔽膜、ブラックマスク等の記載は省略する。

【0126】図12において、21は活性層であり、その一部（ドレイン領域側）には補助容量の下部電極部22が形成されている。また、活性層21の上にはゲイト電極（ゲイト線）23が配置され、下部電極22の上には補助容量の上部電極24が配置される。なお、下部電極22は上部電極24によって覆われてしまうので図12では点線で示している。勿論、下部電極22と上部電極24との間にはゲイト絶縁膜が挟持されて補助容量を

形成している。

【0127】そして、ゲイト電極23、上部電極24と交差する様にしてソース電極（ソース線）25が形成される。このソース電極25はコンタクト部26で活性層21のソース領域と電氣的に接続している。

【0128】実際には、活性層や各配線を遮蔽する様にブラックマスクが設けられたり、上下配線間に電界遮蔽膜が設けられたりする。そして、図示しない画素電極がコンタクト部27で活性層21のドレイン領域と電氣的に接続する。

【0129】以上の様な構造とすれば、透過型液晶表示装置を作製することができる。なお、本発明は図12に示した装置構造に限定されないことは言うまでもない。

【0130】〔実施例13〕実施例1で説明した反射型液晶表示装置を簡略化した断面図を図13に示す。なお、アクティブマトリクス基板の説明は実施例1で既に行ったので、ここではそれ以外の構造について説明する。

【0131】図13において、31は透光性を有する基板、302は透明導電膜である。ここでは省略しているが、透光性基板31の上には他にもカラーフィルター、配向膜、ブラックマスク等が設けられる場合がある。また、そして、これらをまとめて対向基板と呼ぶ。

【0132】対向基板とアクティブマトリクス基板の間では封止材33に囲まれて液晶層34が挟持されている。本発明はECBモード、ゲストホストモード等のあらゆるモードに対応可能であるので、それに応じて液晶材料を変更すれば良い。また、この様な駆動モードによってカラーフィルターが必要になる場合もある。さらに、液晶表示装置の駆動モードによっては偏光板を用いることもある。

【0133】なお、本実施例では周辺回路の上方には液晶層を配置しない構成とし、周辺回路と対向側の透明導電膜32との間に寄生容量が形成されるのを防いでいる。勿論、基板全面に液晶層が配置される様な構成でも構わない。

【0134】また、図14にアクティブマトリクス基板上に配置される各回路の配置構成の一例を示す。図14において、41は基板、42は下地膜、43は画素マトリクス回路、44はソースドライバ回路、45はゲイトドライバ回路、46はロジック回路である。

【0135】以上は反射型液晶表示装置の概略であるが、透過型液晶表示装置でも基本的な構成は変わらない。この様に、本発明はどの様な構造の液晶表示装置に対しても適用することが可能である。

【0136】〔実施例14〕本発明は液晶表示装置以外の電気光学装置に対して適用することもできる。その様な電気光学装置としては、EL（エレクトロルミネセンス）表示装置、EC（エレクトロクロミクス）表示装置等が挙げられる。

【0137】、〔実施例15〕本実施例では、本発明を利用した電気光学装置を利用する応用製品（電子デバイス）の一例を図15に示す。本発明を利用した応用製品としてはビデオカメラ、スチルカメラ、プロジェクター、ヘッドマウントディスプレイ、カーナビゲーション、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話等）などが挙げられる。

【0138】図15（A）は携帯電話であり、本体2001、音声出力部2002、音声入力部2003、表示装置2004、操作スイッチ2005、アンテナ2006で構成される。本発明は表示装置2004に適用することができる。

【0139】図15（B）はビデオカメラであり、本体2101、表示装置2102、音声入力部2103、操作スイッチ2104、バッテリー2105、受像部2106で構成される。本発明は表示装置2102に適用することができる。

【0140】図15（C）はモバイルコンピュータ（モバイルコンピュータ）であり、本体2201、カメラ部2202、受像部2203、操作スイッチ2204、表示装置2205で構成される。本発明は表示装置2205に適用できる。

【0141】図15（D）はヘッドマウントディスプレイであり、本体2301、表示装置2302、バンド部2303で構成される。本発明は表示装置2302に適用することができる。

【0142】図15（E）はリア型プロジェクターであり、本体2401、光源2402、表示装置2403、偏光ビームスプリッター2404、リフレクター2405、2406、スクリーン2407で構成される。本発明は表示装置2403に適用することができる。

【0143】図15（F）はフロント型プロジェクターであり、本体2501、光源2502、表示装置2503、光学系2504、スクリーン2505で構成される。本発明は表示装置2503に適用することができる。

【0144】以上の様に、本発明の応用範囲は極めて広く、あらゆる分野の表示媒体に適用することが可能である。特に、液晶表示装置をプロジェクターの様な投射型表示装置に用いる場合には、非常に高い解像度が要求される。その様な場合において、本発明は非常に有効な技術である。

【0145】

【発明の効果】触媒元素をゲッターリングするための領域を形成する工程と、補助容量の下部電極を形成する工程とを共通化することで製造プロセスが簡略化される。そのため、スループット、歩留り等が向上し、経済的に有益である。

【0146】さらに、本発明を用いて得られた結晶性膜は触媒元素の効果により結晶性が非常に優れ、かつ、ゲ

ットリング処理によりその触媒元素が除去または低減されている。そのため、半導体装置の活性層として利用した場合、優れた電気特性と高い信頼性とを備えた半導体装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 2】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 3】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 4】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 5】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 6】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 7】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 8】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 9】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 10】 半導体装置の作製工程を示す図。
 【図 11】 画素領域を上面から見た図。
 【図 12】 画素領域を上面から見た図。
 【図 13】 液晶表示装置の断面を示す図。
 【図 14】 アクティブマトリクス基板の概略を示す

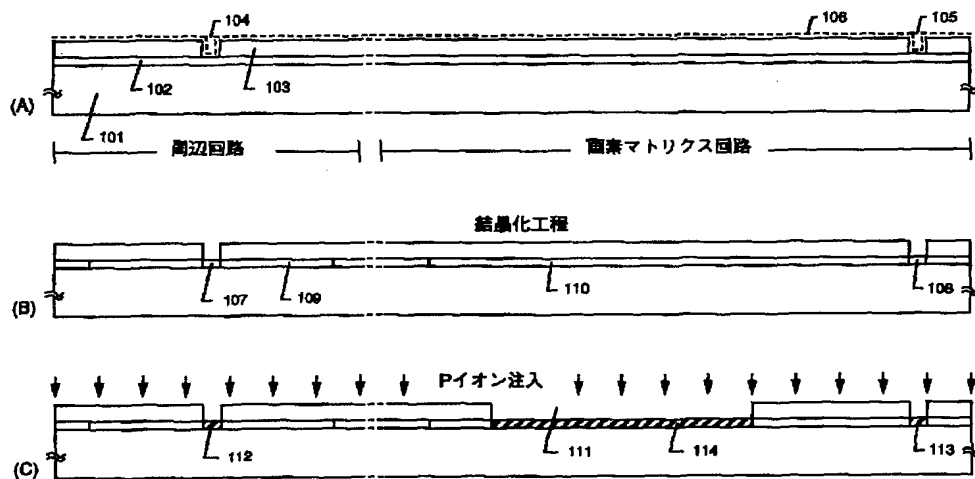
図。

【図 15】 応用製品の一例を示す図。

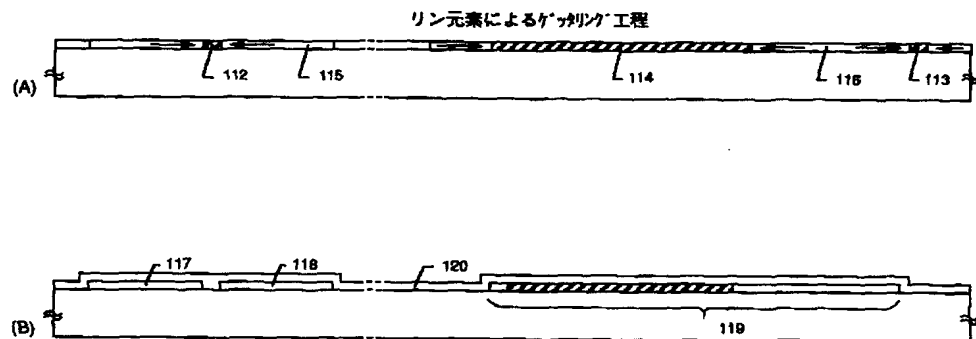
【符号の説明】

- 101 石英基板
 102 非晶質珪素膜
 103 マスク絶縁膜
 104、105 開口部
 106 ニッケル含有層
 107、108 ニッケル添加領域
 10 109、110 横成長領域
 111 開口部
 112、113 リン添加領域（ゲッターリングサイト）
 114 リン添加領域（補助容量の下部電極）
 115、116 横成長領域
 117～119 活性層
 120 ゲイト絶縁膜

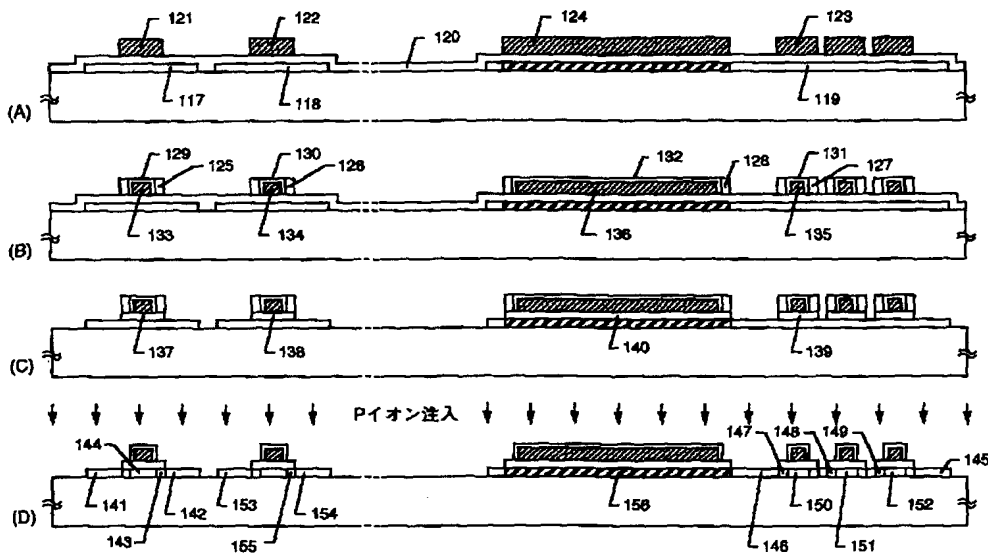
【図 1】



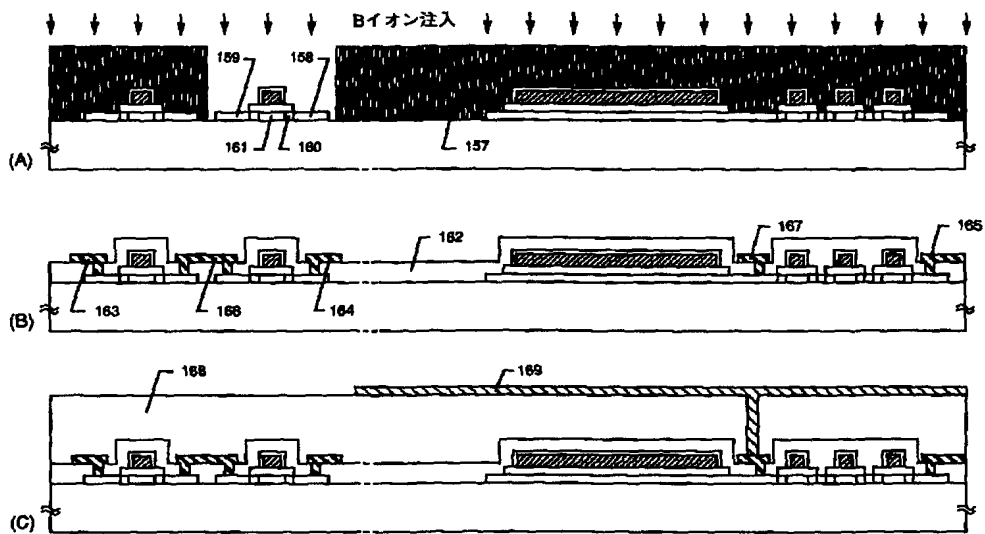
【図 2】



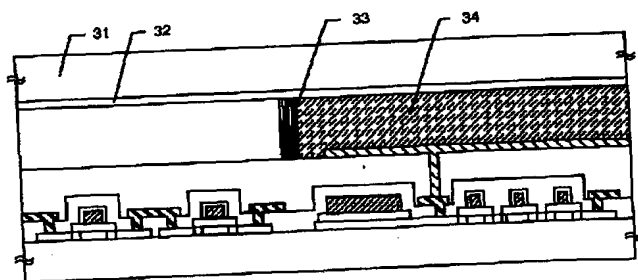
【図 3】



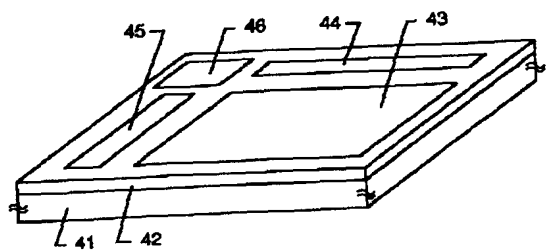
【図 4】



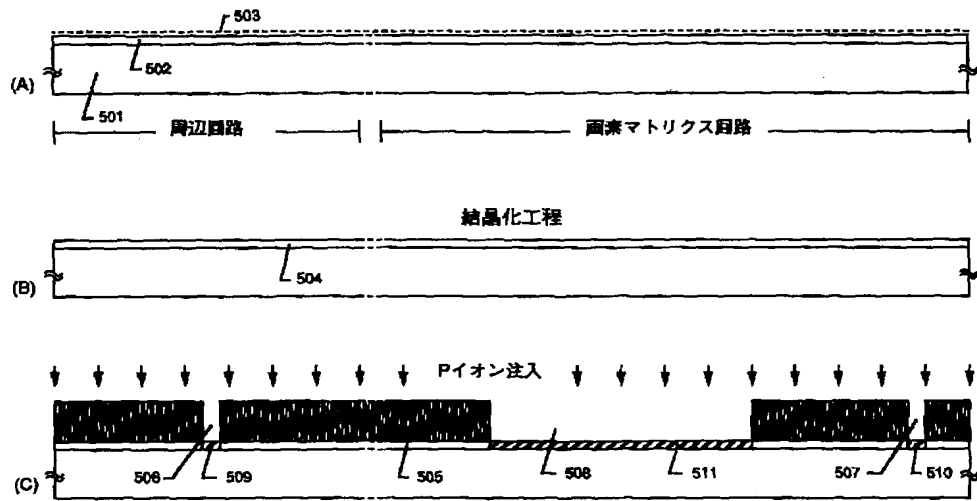
【図 13】



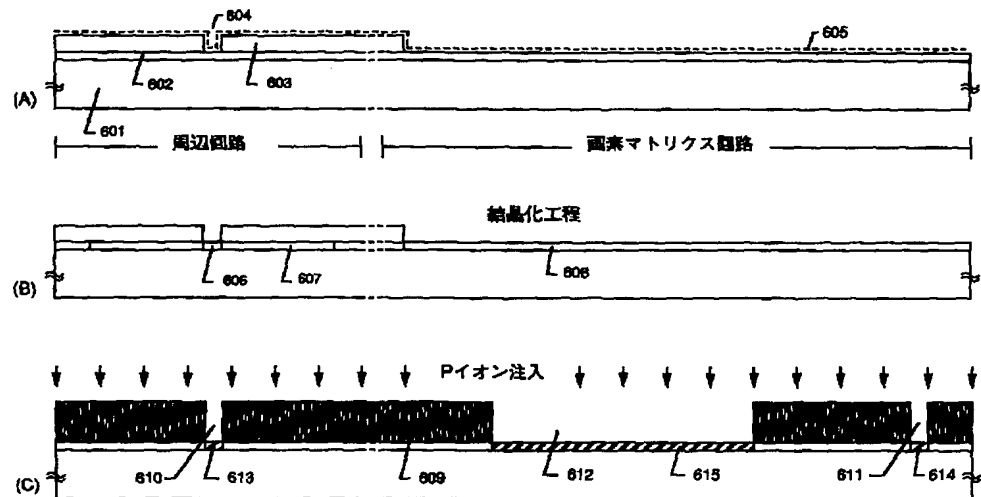
【図 14】



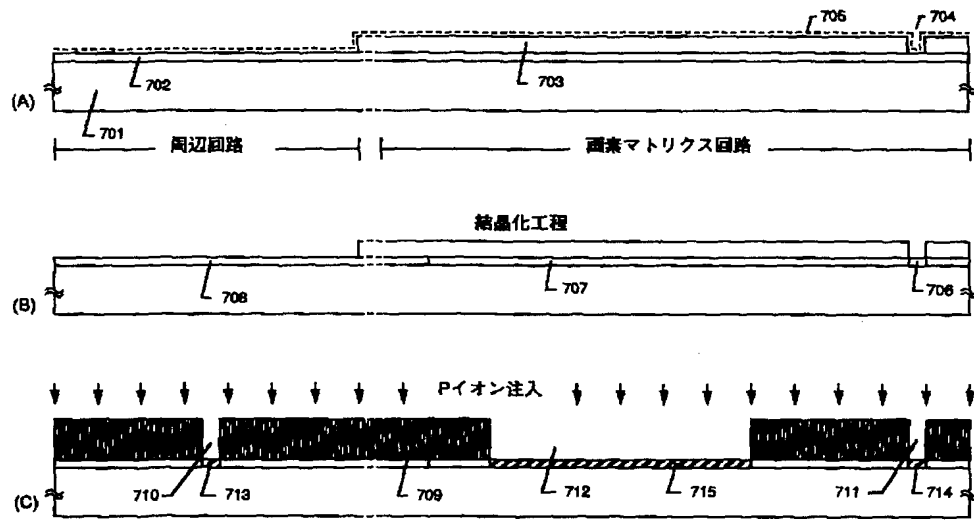
【図 5】



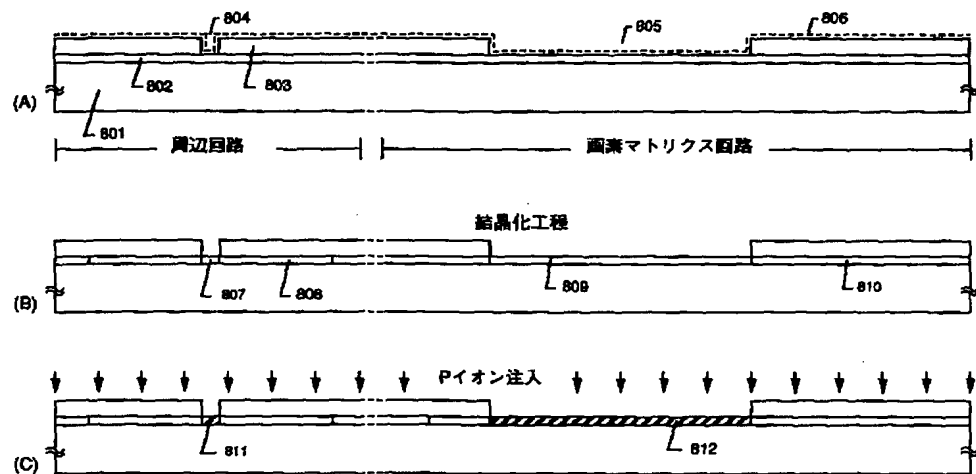
【図 6】



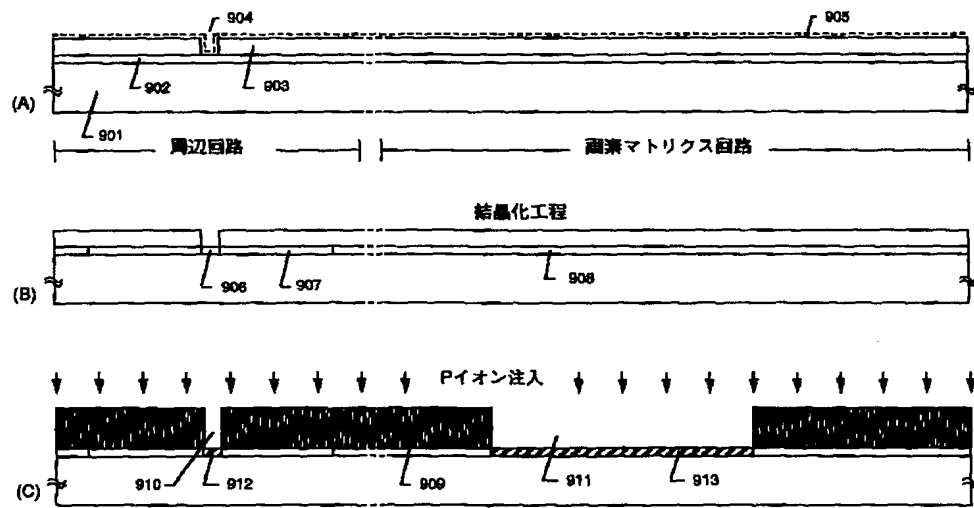
【図 7】



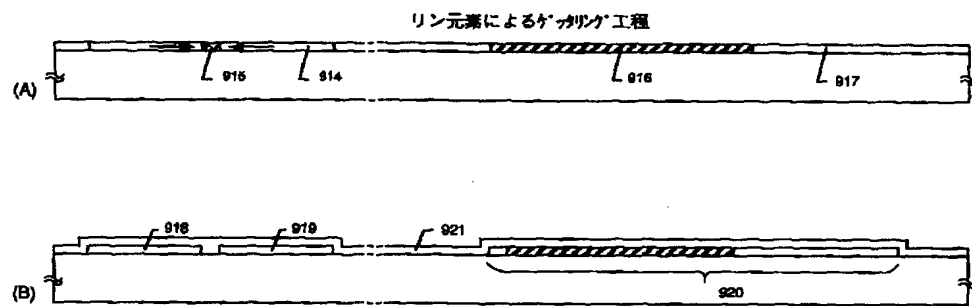
【図 8】



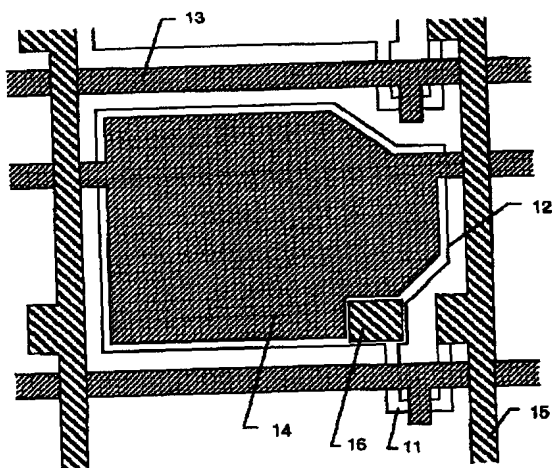
【図 9】



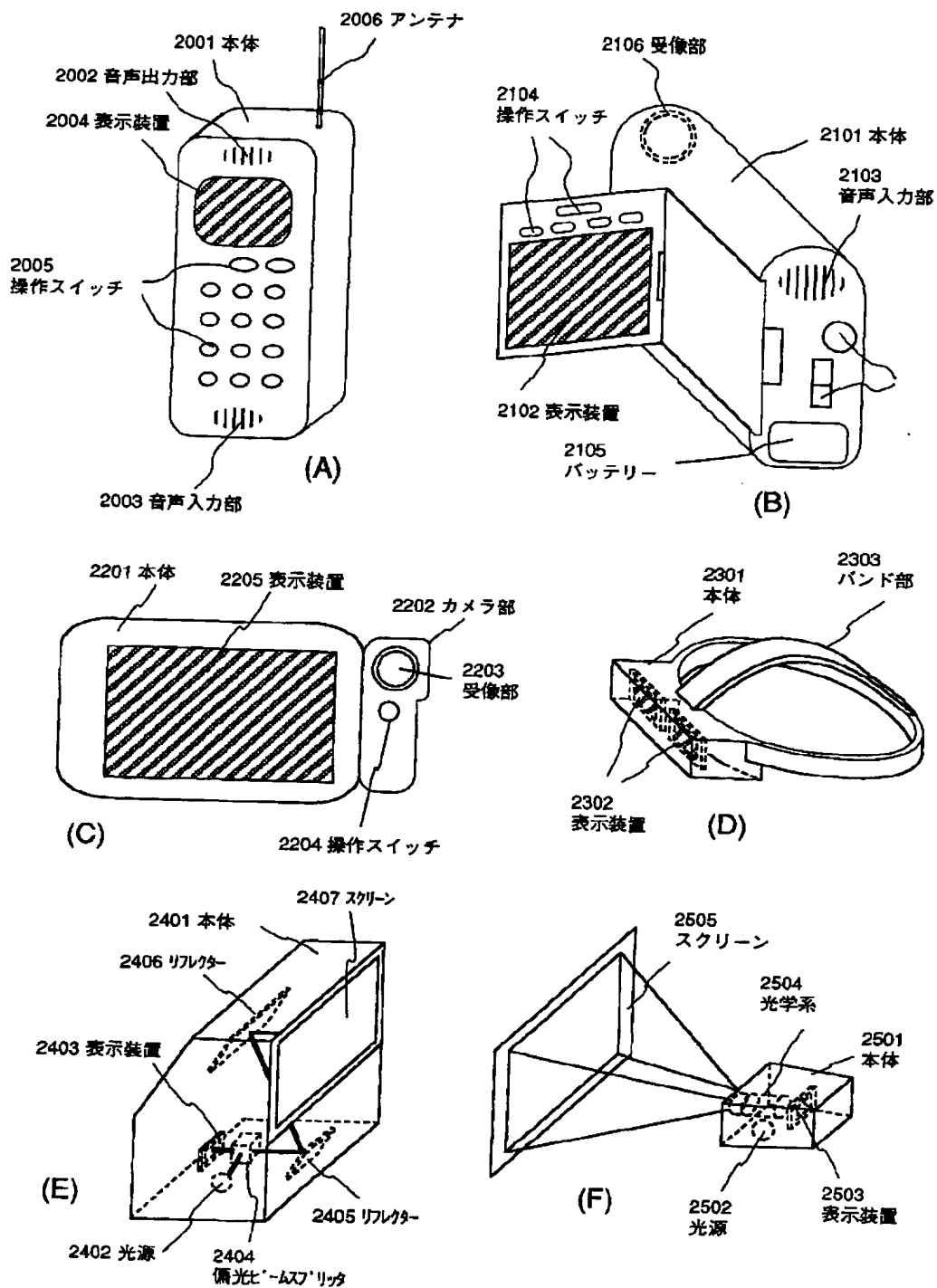
【図 10】



【図 11】



【図 15】



フロントページの続き

(72)発明者 大谷 久
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
 導体エネルギー研究所内